

性能特点：

- 频带：12-18GHz
- 噪声系数：1.4dB
- 增益：21dB
- 输出 P-1dB：13dBm
- 供电：+3.3V@48mA
- 芯片尺寸：1.34mm×0.95mm×0.1mm

产品简介：

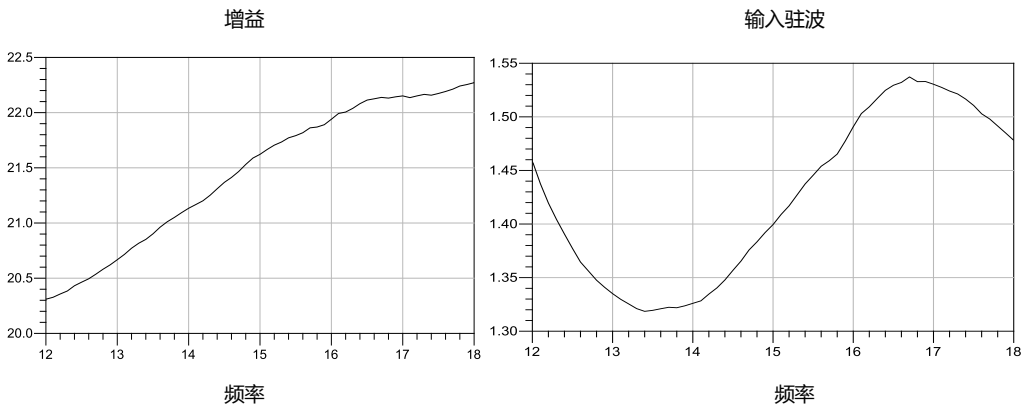
HH-LN1218 是一款 GaAs MMIC 低噪声放大器，其频率范围覆盖 12-18GHz，带内噪声系数为 1.4dB。该芯片采用+3.3V 单电源供电。

电参数： (TA=25°C, VD=+3.3V)

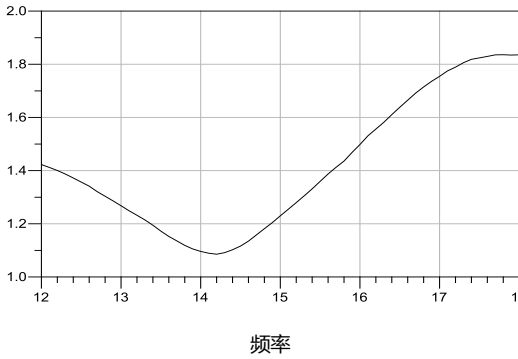
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	12-18			GHz
噪声系数	-	1.4	-	dB
增益	-	21	-	dB
输入驻波	-	1.5	-	dB
输出驻波	-	1.8	-	dB
输出 P1dB	-	13	-	dBm
工作电流	-	48	-	mA

使用极限参数：

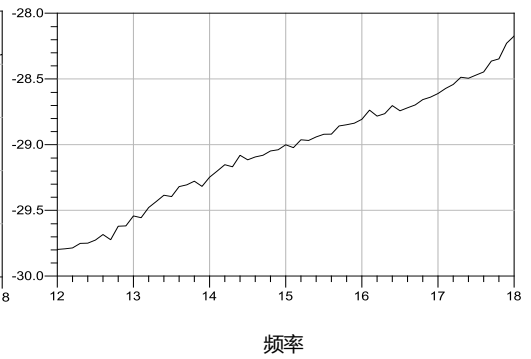
输入功率	23dBm
电压	+7V
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-85°C

典型曲线：


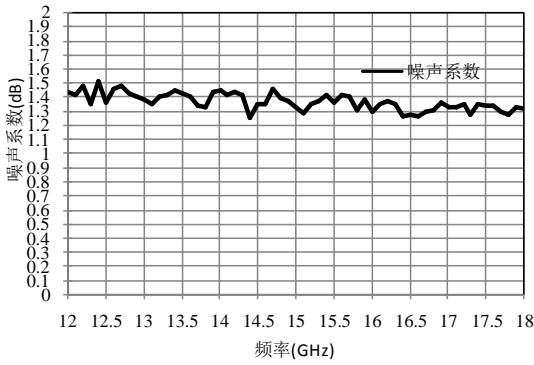
输出驻波



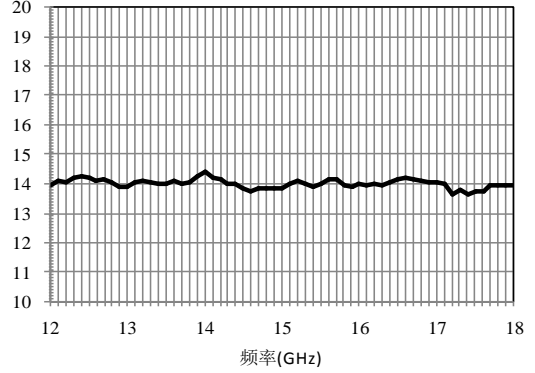
反向隔离



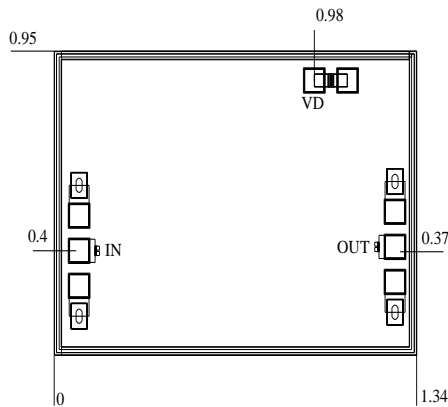
噪声系数

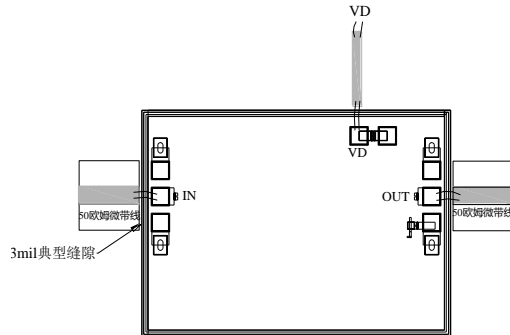


1dB 压缩点输出功率



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：

使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。